

2014 年 5 月 16 日
一般社団法人 新金属協会
化合物半導体部会
部会長 平野 立一
J X 日鉱日石金属株式会社
電材加工事業本部 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット ユニット長

平成 25 年度通期の化合物半導体の出荷統計について

2013 年度通期（2013 年 4 月～2014 年 3 月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2013 年度（2013 年 4 月～2014 年 3 月）の化合物半導体製品の出荷額は、前年度比 104% の 284 億円となり、対前年度で 10 億円の増加となった。結晶別では、主要 3 品目のうち GaP が減少した一方、GaAs が増加、InP は前年並みとなった。用途別では電子デバイスで落ち込んでおり、前年度比 96%となった。一方、可視 LED、赤外 LED 及び LD はそれぞれ前年度比 102%、110%、106%の伸びとなった。

1.GaAs

2013 年度の GaAs の売上高は前年度比 107%となった。半期の内訳では、上期が前年同期比 108%、下期が同 105%であった。地域別では輸出が前年同期比 114%と増加したのに対し、国内市場は同 93%と減少する結果となった。

GaAs の主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外 LED、および DVD 等に使用されるレーザダイオード (LD) 等があるが、2013 年度は主に赤外 LED の伸びが GaAs 市場を牽引したものと推定している。

原料である Ga のロイター価格は、足元は比較的安定した推移を示している。

2.GaP

2013 年度の GaP の売上高は前年度比 88%と低調で 3 年連続のマイナス成長となった。GaP は赤、橙、黄、黄緑色の LED に使用されていたが、安価で高輝度な中国製 AlInGaP 系 LED への置き換えが進み、GaP 系 LED および GaAsP 系 LED は車載、家電等の特定市場に絞り込まれている。

売上高の前年度比は 2011 年度 68%、2012 年度 85%、2013 年度 88%と減少幅は鈍化しており、今後も減少傾向ではあるが一定の売上高を維持すると推察している。

3.InP

2013 年度の InP の売上高は前年度比 101%とほぼ前年度並みであった。半期の内訳では、上期は前年度比 101%、下期は前年度比 102%であった。

InP の主要な用途としては、光通信用受発光素子がある。スマートフォン、クラウドコンピューティング等の普及による通信量の増大を背景に、2013 年度は前年に引き続き光通信用部品の所要が堅調に推移した結果と推察している。

＜お問い合わせ先＞

J X 日鉱日石金属株式会社

電材加工事業本部 薄膜材料事業部

化合物半導体ユニット 主席技師

中村 正志

電話 03-5299-7286 Fax 03-5299-7349

e-mail : masashi_nakamura@nmm.jx-group.co.jp